

# Экранирование низкочастотного электрического поля тонкостенной незамкнутой сферической оболочкой с учетом емкостных свойств

ЕРОФЕЕНКО В.Т., ШУШКЕВИЧ Г.Ч.

*Решение задачи экранирования низкочастотного электрического поля тонкостенной незамкнутой сферической оболочкой сведено к решению интегрального уравнения Фредгольма второго рода. Получена формула для вычисления коэффициента экранирования. Приведены результаты вычислительного эксперимента.*

**Ключевые слова:** низкочастотное электрическое поле, интегральное уравнение, коэффициент экранирования, уравнение Лапласа

Источниками низко- и высокочастотных электромагнитных полей (ЭМП) являются радио- и телевизионные передающие устройства, системы обычной и сотовой связи, радиотелефоны. Уровень этих полей достаточно высок, что приводит к ухудшению параметров электромагнитной среды, снижению эффективности работы технических средств и обслуживающего персонала [1–4]. Наиболее эффективным средством снижения уровня ЭМП (электрической и магнитной напряженности) в окружающей среде является применение активного и пассивного экранирования либо пространства, в котором желательно снизить уровень ЭМП, либо технических средств, влияние на которые внешнего ЭМП следует исключить [5–7]. В [8–10] предложена методика расчета низкочастотных электромагнитных полей для случая, когда незамкнутые экраны являются идеально проводящими. В этом случае поле не проникает через стенки экранов. Для экранов же с низкой проводимостью материала поле проникает через стенку оболочки – для моделирования таких процессов используют неклассические граничные условия [11].

В статье решена краевая задача с неклассическими граничными условиями, описывающими процесс проникновения низкочастотного электрического поля через тонкую незамкнутую сферическую оболочку с учетом емкостных свойств оболочки.

**Постановка задачи.** В пространстве  $R^3$  с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon_0$  и магнитной проницаемостью  $\mu_0$  расположена полупрозрачная тонкостенная незамкнутая сферическая оболочка  $\Gamma_D$  толщиной  $D$ . Оболочка  $\Gamma_D$  выполнена из материала с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$  магнитной проницаемостью  $\mu$  удельной электрической про-

*The solution of the problem of shielding a low-frequency electric field by an open thin-walled spherical shell is reduced to solving Fredholm's integral equation of the second kind. A formula for calculating the shielding factor is obtained, and results from a numerical experiment are presented.*

**Key words:** low-frequency electric field, integral equation, shielding factor, Laplace equation

водимостью  $g$  и расположена на поверхности сферы  $\Gamma_1$  радиусом  $a$ , круговое отверстие имеет угол раствора  $q_0$  (рис. 1). Оболочку  $\Gamma_D$  заменим на идеальную поверхность  $\Gamma = \{r = a, q_0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$ .

Для решения задачи свяжем с точкой  $O$  сферические координаты  $\{r, \varphi, \psi\}$ :

$$x = r \cos \psi \sin \varphi; \quad y = r \sin \psi \sin \varphi; \quad z = r \cos \varphi,$$

где  $0 \leq r < \infty$ ;  $0 \leq \varphi \leq \pi$ ;  $0 \leq \psi \leq 2\pi$ .

В пространстве распространяется первичное низкочастотное электрическое поле с электрическим потенциалом  $u_0$ , изменяющимся с круговой частотой  $\omega$ . Для электрического потенциала  $u_1$  поля внутри сферической поверхности и для потенциала  $u_2 = u_0 + u_{\text{эк}}$  вне поверхности  $\Gamma_1$  сформулируем краевую задачу экранирования со специальными граничными условиями [11] на поверхности экрана  $\Gamma$ :

$$Du_1 = 0, \quad 0 \leq r < a, \quad Du_{\text{эк}} = 0, \quad r > a; \quad (1)$$

$$u_1|_{\Gamma_1 \setminus \Gamma} = u_2|_{\Gamma_1 \setminus \Gamma}, \quad \frac{\partial u_1}{\partial \vec{n}}|_{\Gamma_1 \setminus \Gamma} = \frac{\partial u_2}{\partial \vec{n}}|_{\Gamma_1 \setminus \Gamma}, \quad 0 \leq \varphi < q_0; \quad (2)$$

$$u_1|_{\Gamma} = u_2|_{\Gamma} + V, \quad V = \text{const},$$

$$\frac{\partial (u_2 - u_1)}{\partial \vec{n}}|_{\Gamma} = -apF(u_2 + u_1)|_{\Gamma}, \quad q_0 < \varphi \leq \pi. \quad (3)$$

где  $F(u) = (\vec{n}, \text{rot}[\vec{n}, \text{grad}u]) = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{u}{r} \right) \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial}{\partial \varphi}$ ;  $p = \frac{\epsilon \mu \omega^2}{2\epsilon_0 a}$ ;

$d = \frac{2}{k} \text{tg} \frac{kD}{2}$ ;  $k = \omega \sqrt{\epsilon \mu}$ ,  $0 \leq \arg k < \pi$ ;  $\epsilon = \epsilon' + i \frac{g}{\omega}$ ;  $\vec{n} = \vec{e}_r$  – внешний нормальный единичный вектор к поверхностям  $\Gamma$ ,  $\Gamma_1 \setminus \Gamma$ , условию на бесконечности

$$u_2(M) \approx 0 \text{ при } M \in \Sigma, \quad (4)$$

$M$  – произвольная точка пространства.

Реальные электрические потенциалы и электрические поля определяются формулами:

$$V_j = \text{Re}(u_j e^{-i\omega t}), \quad \vec{E}_j = -\text{grad} V_j, \quad i - \text{мнимая единица}, \quad j=1,2.$$

Отметим, что в [12] использовалось граничное условие сопряжения вида

$$\frac{\partial(u_2 + u_1)}{\partial \vec{n}} \Big|_{\Gamma} = -aqF(u_2 - u_1) \Big|_{\Gamma}, \quad q = \frac{2}{w^2 \epsilon_0 \pi da}.$$

Вычислительный эксперимент показал, что величина  $q$  принимает достаточно большое значение. Поэтому в данном граничном условии пренебрегаем величиной

$$\frac{1}{q} \frac{\partial(u_2 + u_1)}{\partial \vec{n}} \Big|_{\Gamma}$$

и получаем граничное условие  $F(u_2 - u_1) \Big|_{\Gamma} = 0$ . Так как в операторе  $F$  дифференцирование осуществляется вдоль поверхности  $\Gamma$ , то получим первое граничное условие (3), которое позволяет учитывать ёмкостные свойства оболочки  $\Gamma_1$ .

Можно воспользоваться другим обоснованием. Предполагается, что на одной стороне экрана располагаются распределенные по поверхности положительные заряды, а на другой – отрицательные. Считается, что заряды не могут нейтрализоваться путем передвижения с одной стороны экрана на другую. Такая структура описывается потенциалом двойного слоя, который терпит разрыв первого рода. Указанный разрыв потенциала описывается первым граничным условием (3).

**Выполнение граничных условий.** Представим решение задачи (1)–(3) в виде суперпозиции по базисным решениям уравнения Лапласа в сферической системе координат так, чтобы выполнялось условие на бесконечности (4):

$$u_1 = \sum_{n=0}^{\infty} x_n \frac{e^{-\gamma r}}{r^{\gamma}} P_n(\cos \varphi), \quad 0 \leq r < a; \quad (5)$$

$$u_2 = \sum_{n=0}^{\infty} y_n \frac{e^{-\gamma r}}{r^{\gamma}} P_n(\cos \varphi), \quad r > a,$$

где  $x_n, y_n$  – неизвестные коэффициенты, подлежащие определению;  $P_n(\cos \varphi)$  – полиномы Лежандра [13].

В качестве первичного электрического поля примем поле электрического диполя, ориентированного вдоль оси  $Oz$  с точечными зарядами  $Q$  и  $-Q$ , расположенными соответственно в точках  $M_1(0,0,-h_1), M_2(0,0,-h_2)$ :

$$u_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+h_1)^2}} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+h_2)^2}}$$

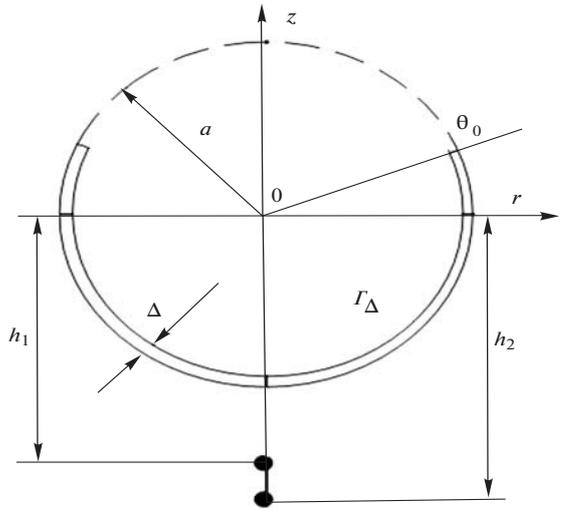


Рис. 1. Осевое сечение экрана

$$u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+h_2)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+h_1)^2}}, \quad h_2 > h_1 > a.$$

Полярность диполя меняется с частотой  $f, \omega = 2\pi f$  – круговая частота.

Потенциал этого поля в окрестности сферической оболочки равен [14]:

$$u_0 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{e^{-\gamma r}}{r^{\gamma}} P_n(\cos \varphi), \quad 0 \leq r < a, \quad (6)$$

где  $a_n = \frac{(-1)^n Q Q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{a^n}{h_1^{n+1}} - \frac{a^n}{h_2^{n+1}}$

Учитывая представления (5), (6) и выполняя граничные условия (2), (3), с учетом разложения

$$f(\varphi) = \begin{cases} 0, & 0 \leq \varphi < \varphi_0 \\ V, & \varphi_0 < \varphi \leq \pi \end{cases} = \sum_{n=0}^{\infty} f_n P_n(\cos \varphi)$$

получаем соотношение между коэффициентами  $x_n, y_n$ :

$$x_n = f_n + y_n + a_n, \quad (7)$$

где  $f_n = V \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \int_{\varphi_0}^{\pi} P_n(\cos \varphi) \sin \varphi d\varphi = \frac{2n+1}{2n(n+1)}$

$$V \sin \varphi_0 P_n^1(\cos \varphi_0), \quad n \geq 1; \quad f_0 = 0,5V(1 + \cos \varphi_0),$$

и парные сумматорные уравнения по полиномам Лежандра вида:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (nx_n + (n+1)y_n) P_n(\cos \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} na_n P_n(\cos \varphi), \quad 0 \leq \varphi < \varphi_0; \quad (8)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n(1+(n+1)p)x_n + (n+1)(1+np)y_n) P_n(\cos \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} n(1-(n+1)p)a_n P_n(\cos \varphi), \quad \varphi_0 < \varphi \leq \pi.$$

Исключим из (8) коэффициенты  $x_n$  с помощью представления (7) и введем в рассмотрение новые величины:

$$(2n + 1)T_n = D_n y_n + (2n(n + 1)p)a_n + n(1 + (n + 1)p)f_n, \quad n = 0, 1, \dots; \quad (9)$$

$$g_n = \frac{2n + 1 - p/2}{2n + 1 + 2n(n + 1)p}; \quad D_n = 2n + 1 + 2n(n + 1)p,$$

тогда парные уравнения (8) преобразуются к виду:

$$\sum_{n=0}^{\infty} g_n T_n P_n(\cos q) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n a_n + b_n f_n) P_n(\cos q); \quad 0 \leq q < q_0; \quad (10)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) T_n P_n(\cos q) = 0, \quad q_0 < q \leq p,$$

где  $a_n = \frac{n(n + 1)(2n + 1)p^2}{D_n}; \quad b_n = \frac{n(n + 1)p^2}{2D_n}.$

Преобразуем парные сумматорные уравнения (10) к регулярному интегральному уравнению Фредгольма второго рода. Для этого введем в рассмотрение новую функцию  $j(t)$ , которая связана с коэффициентами  $T_n$  соотношением:

$$T_n = \int_0^{q_0} j(t) \cos(n + 0,5)t dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (11)$$

После преобразований получим [15, 16]:

$$j(x) - \int_0^{q_0} K(x, t) j(t) dt = G(x), \quad 0 < x < q_0, \quad (12)$$

где  $G(x) = \frac{2}{p} \sum_{n=0}^{\infty} (a_n a_n + b_n f_n) \cos(n + 0,5)x.$

Ядро интегрального уравнения имеет вид

$$K(x, t) = \frac{2}{p} \sum_{n=0}^{\infty} g_n \cos(n + 0,5)x \cos(n + 0,5)t = K_0(x, t) + K_1(x, t), \quad (13)$$

где

$$K_0(x, t) = \frac{4}{p} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_n(x, t)}{2n + 1} = \frac{1}{p} \left[ \ln \frac{e^{ix} + t}{e^{-ix} + t} + \ln \frac{e^{ix} - t}{e^{-ix} - t} \right]$$

$$K_1(x, t) = \frac{1}{p} \sum_{n=0}^{\infty} d_n C_n(x, t); \quad C_n(x, t) = \cos \frac{1}{2} n x \cos \frac{1}{2} n t + \sin \frac{1}{2} n x \sin \frac{1}{2} n t;$$

$$d_n = \frac{2 - (2n + 1)(p + 4/p)}{(2n + 1)(2n + 1 + 2n(n + 1)p)}, \quad d_n = O(n^{-2}) \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

**Вычисление коэффициента экранирования.** Изменение напряженности электрического поля в про-

извольной точке  $M_0$  внутри сферической оболочки в течение периода  $T = 2\pi/\omega$  определяется по формуле

$$\bar{E}_1(M_0, \bar{t}) = - \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}(x_n \exp(-2\pi i \bar{t})) \frac{e^{-\alpha_n \bar{t}}}{e^{\alpha_n \bar{t}}} \cdot (nP_n(\cos q) \bar{e}_r + P_n^1(\cos q) \bar{e}_q),$$

где  $0 \leq \bar{t} \leq 1, \bar{t} = t/T$  – безразмерное время в отн. ед.

Если точка  $M_0(0, 0, z)$  находится на оси  $Oz$ , то  $|z| < a, q = 0$  ( $\cos q = 1, P_n^1(1) = 1$ ) или  $q = \pi$  ( $\cos q = -1, P_n^1(-1) = (-1)^n$ ),  $P_n^1(\pm 1) = 0$ , и тогда

$$\bar{E}_1(M_0, \bar{t}) = \begin{cases} E_1^{(+)}(M_0, \bar{t}) \bar{e}_r, & 0 \leq z < a, \quad q = 0; \\ E_1^{(-)}(M_0, \bar{t}) \bar{e}_r, & -a < z \leq 0, \quad q = \pi, \end{cases}$$

где

$$E_1^{(+)}(M_0, \bar{t}) = - \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{Re}(x_n \exp(-2\pi i \bar{t})) \frac{e^{-\alpha_n \bar{t}}}{e^{\alpha_n \bar{t}}}, \quad 0 \leq z < a;$$

$$E_1^{(-)}(M_0, \bar{t}) = - \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \operatorname{Re}(x_n \exp(-2\pi i \bar{t})) \frac{e^{-\alpha_n \bar{t}}}{e^{\alpha_n \bar{t}}}, \quad -a < z \leq 0;$$

$$x_n = f_n + a_n + ((2n + 1)T_n - 2n(n + 1)p a_n - n(1 + (n + 1)p)f_n) / D_n.$$

Коэффициент экранирования (ослабления) поля в точке  $M_0$ , расположенной на оси  $Oz$  внутри сферической оболочки, вычисляем по формуле

$$K^{(\pm)}(M_0, \bar{t}) = \frac{|E_1^{(\pm)}(M_0, \bar{t})|}{|E_0^{(\pm)}(M_0, \bar{t})|}, \quad (14)$$

где

$$E_0^{(+)}(M_0, \bar{t}) = - \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} a_n n \cos(2\pi \bar{t}) \frac{e^{-\alpha_n \bar{t}}}{e^{\alpha_n \bar{t}}}, \quad 0 \leq z < a;$$

$$E_0^{(-)}(M_0, \bar{t}) = - \frac{1}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n n \cos(2\pi \bar{t}) \frac{e^{-\alpha_n \bar{t}}}{e^{\alpha_n \bar{t}}}, \quad -a < z \leq 0; \quad a_n - \text{действительное число.}$$

**Вычислительный эксперимент.** Для численного решения интегрального уравнения (12) воспользуемся методом коллокации. Разобьем отрезок  $[0, q_0]$  на  $N$  частичных отрезков  $[q_0^0, q_0^1], [q_0^1, q_0^2], \dots, [q_0^{N-1}, q_0^N]$  длиной  $h = q_0/N, q_0^s = sh, s = 0, 1, \dots, N, q_0^N = q_0$ . Приближенное решение интегрального уравнения ищем в виде линейной комбинации:

$$j(t) = \sum_{n=1}^N C_n y_n(t), \quad y_n(t) - \text{базисные функции.} \quad (15)$$

В качестве базисных функций выбираем систему функций Хаара [18], а в качестве точек коллокации – точки  $x^{(m)} = (q_0^m + q_0^{m-1})/2$  – середины частичных отрезков. В результате получим систему линейных алгебраических уравнений для определения коэффициентов  $C_n$ :

$$\sum_{n=1}^N C_n \int_{q_0^{n-1}}^{q_0^n} K(x^{(m)}, t) dt = G(x^{(m)}), \quad m = 1, \dots, N, \quad (16)$$

где  $G(x^{(m)}) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n a_n + b_n f_n) \cos(n + 0,5)x^{(m)}$ .

Решая систему (16), вычисляем коэффициенты  $T_n$  по формуле:

$$T_n = \sum_{j=1}^N C_j \int_{q_0^{j-1}}^{q_0^j} \cos(n + 0,5)tdt.$$

Кроме того, для получения достоверного решения системы линейных алгебраических уравнений (16) необходимо проверить обусловленность системы. Матрица, соответствующая системе, считается хорошо обусловленной, если число обусловленности матрицы  $\ll 1$  [19].

Был проведен вычислительный эксперимент. Число обусловленности системы линейных алгебраических уравнений в пространстве  $L_1, L_2$  [20] для рассмотренных параметров задачи не превышало 40. При выполнении расчетов бесконечные суммы, входящие в представление интегральных уравнений (12), вычислялись с точностью  $10^{-5}$  при шаге  $h = 0,05$ . Расчеты выполнялись в системе компьютерной математики Mathcad 14 [21].

В ходе вычислений были получены значения коэффициента экранирования  $K^{(+)}(M_0, 0)$  для некоторых углов раствора  $q_0$  незамкнутой полупрозрачной сферической оболочки  $\Gamma$  и следующих параметров:  $h_1/a = 1,2$ ;  $h_2/a = 1,201$ ;  $D/a = 0,1$ ;  $f = 100$  Гц;  $\epsilon = 50\epsilon_0$ ;  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$  Ф/м;  $g = 0$ ;  $m = m_0$ ;  $m_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  Гн/м;  $V = 1$  В;  $Q = 0,01$  Кл.

На рис. 2 представлены графики  $K^{(+)}(M_0, 0)$ ,  $0 \leq z/a < 1$  для углов раствора  $q_0$ : 1 –  $100^\circ$ , 2 –  $90^\circ$ , 3 –  $60^\circ$ , 4 –  $45^\circ$ , 5 –  $30^\circ$ .

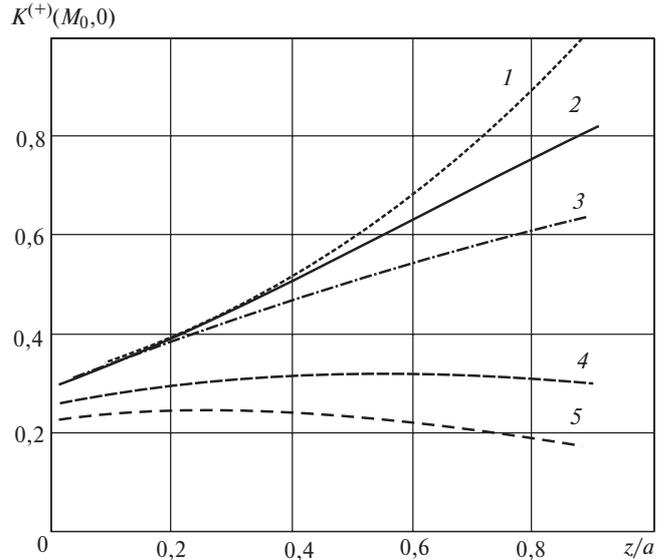


Рис. 2. Зависимости коэффициента экранирования от  $z/a$  для  $D/a = 0,1$ ,  $f = 100$  Гц и различных углов раствора  $q_0$

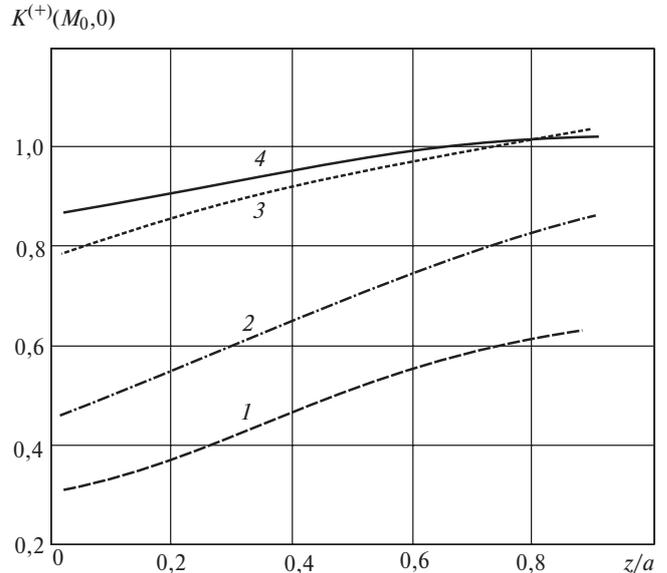


Рис. 3. Зависимости коэффициента экранирования от  $z/a$  для различных значений  $D/a$

На рис. 3 представлены графики  $K^{(+)}(M_0, 0)$ ,  $0 \leq z/a < 1$  для угла раствора  $q_0 = 60^\circ$ ,  $f = 1000$  Гц и различных значений отношений толщины оболочки  $D$  к радиусу  $D/a$ : 1 – 0,1; 2 – 0,05; 3 – 0,01; 4 – 0,005.

На рис. 4 представлены графики  $K^{(+)}(M_0, 0)$ ,  $0 \leq z/a < 1$  для угла раствора  $q_0 = 60^\circ$ ,  $f = 1000$  Гц,

Потенциал $V$	Значения коэффициентов экранирования при отношениях $z/a$ , равных						
	0,01	0,21	0,41	0,61	0,91	- 0,51	- 0,91
0,01	0,768556	0,828029	0,875641	0,911813	0,948297	0,560321	0,317385
100	0,768604	0,828101	0,875732	0,911915	0,948408	0,560327	0,317386
10000	0,773313	0,835131	0,884677	0,922087	0,959392	0,560942	0,317412

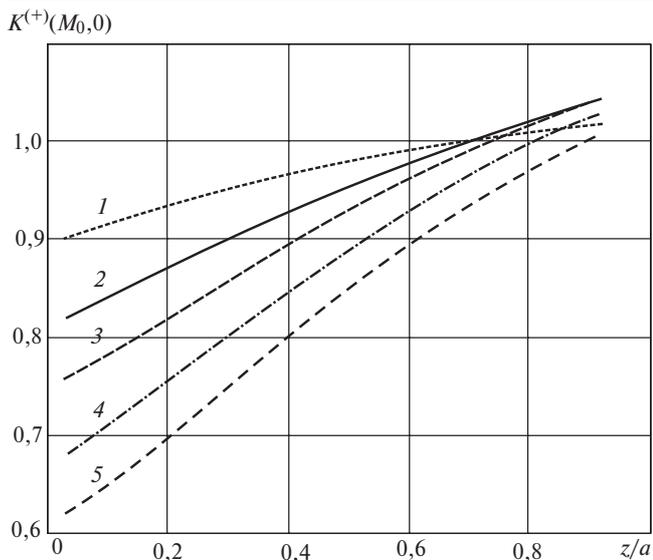


Рис. 4. Зависимости коэффициентов экранирования от  $z/a$  для различных значений  $e/e_0$

$D/a = 0,01$  и различных значений отношений  $e/e_0$ : 1 — 20; 2 — 40; 3 — 60; 4 — 90; 5 — 120.

В таблице приведены значения коэффициентов экранирования  $K^{(+)}(M_0, 0)$  при изменении потенциала  $V$ , значений  $-1 < z/a < 1$  и следующих параметров:  $h_1/a = 1,2$ ;  $h_2/a = 1,201$ ;  $D/a = 0,01$ ;  $q_0 = 90^\circ$ ;  $f = 500$  Гц;  $e = 50e_0$ ;  $g = 0$ ;  $m = m_0$ ;  $Q = 0,1$  Кл.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронин Г.П. Электромагнитная совместимость: безопасность электронных систем и аппаратуры, защита окружающей среды и здоровья человека. — Электроника: Наука, технология, бизнес, 2000, № 2.
2. Павлов А.Н. Воздействие электромагнитных излучений на жизнедеятельность. — М.: Гелиос АРВ, 2002.
3. Довгуша В.В., Тихонов М.Н., Довгуша Л.В. Влияние естественных и техногенных электромагнитных полей на безопасность жизнедеятельности. — Экология человека, 2009, № 12.
4. Бородай П.Н., Мырова Л.О. Опасные электромагнитные излучения от персональных компьютеров и защита от них. — Информационно-измерительные и управляющие системы, 2006, т.4, № 1–3.
5. Резинкина М.М. Использование численных расчетов для выбора средств экранирования от действия магнитного поля. — ЖТФ, 2007, т.77, вып.11.
6. Шапиро Д.Н. Электромагнитное экранирование. — Долгопрудный: Издат. дом «Интеллект», 2010.
7. Apollonskii S.M., Erofeenko V.T., Shushkevich G.Ch. Shielding of Electromagnetic Fields by System of Passive and Active Screens. — Proc. of St. Petersburg IEEE Chapters, 2003.

8. Ерофеенко В.Т., Шушкевич Г.Ч. Экранирование низкочастотных электрических полей системой экранов: тонкая незамкнутая сферическая оболочка — тонкостенная сферическая проницаемая оболочка. — ЖТФ, 2003, т.73, вып.3.

9. Аполлонский С.М., Ерофеенко В.Т. Электромагнитные поля в экранирующих оболочках. — Минск: Университетское, 1988.

10. Shushkevich G.Ch. Modelling of electromagnetic fields in problems of shielding. Computer Algebra Systems in Teaching and Research. — Proc. 4-th International Workshop, 2007.

11. Аполлонский С.М., Ерофеенко В.Т. Эквивалентные граничные условия в электродинамике. — СПб: Безопасность, 1999.

12. Козловская И.С., Ерофеенко В.Т. Модели электрических процессов в сферической тонкостенной оболочке с отверстием. — Вестник БГУ, сер. 1: Физ., Мат., Информ., 2008, № 1.

13. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами/Под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. — М.: Наука, 1979.

14. Ерофеенко В.Т., Козловская И.С. Основы математического моделирования. — Минск: БГУ, 2002.

15. Шушкевич Г.Ч. Расчет электростатических полей методом парных, тройных уравнений с использованием теорем сложения. — Гродно: ГрГУ, 1999.

16. Уфлянд Я.С. Метод парных уравнений в задачах математической физики. — Л.: Наука, 1977.

17. Гримальский О.В. Модели электромагнитной дифракции на тонких однородных оболочках. — Радиотехника и электроника, 2005, т.59, № 3.

18. Дмитриев В.И., Захаров Е.В. Интегральные уравнения в краевых задачах электродинамики. — М.: МГУ, 1987.

19. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение. — М.: Мир, 1998.

20. Вержицкий В.М. Основы численных методов. — М.: Высшая школа, 2002.

21. Шушкевич Г.Ч., Шушкевич С.В. Компьютерные технологии в математике. Система Mathcad 14, ч. 1. — Минск: Изд. Гревцова, 2010.

[17.12.10]

Авторы: Ерофеенко Виктор Тихонович окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1969 г. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию «Метод теорем сложения и теория усредненных граничных условий в краевых задачах электродинамики». Профессор кафедры математической физики факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета (БГУ).

Шушкевич Геннадий Чеславович окончил факультет прикладной математики БГУ в 1976 г. В 2008 г. защитил докторскую диссертацию «Моделирование полей в многосвязных областях в задачах электростатики и экранирования». Заведующий кафедрой информатики и компьютерного моделирования Гродненского государственного университета имени Я. Купалы (Республика Беларусь).